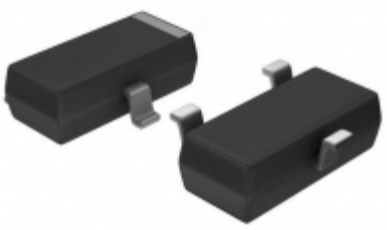
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2312BDS-T1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 3.9A SOT23-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2312BDS-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 179033 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

## Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2312BDS-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.9A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	179033 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3.9A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2312BDS-T1-GE3TR

SI2312BDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2312BDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2312BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2312BDS-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2312CDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A SOT-23</p>	 <p><b>SI2312BDS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.9A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2312CDS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A SOT-23</p>	 <p><b>SI23120</b> VISHAY SI23120 VISHAY</p>
 <p><b>SI2312BDS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3.9A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2312BDS-T1</b> VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p><b>SI2312CDS-T1-E3</b> VISHA SI2312CDS-T1-E3 VISHA</p>	 <p><b>SI2312BDS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.9A SOT23-3</p>

## heiße Teile

Mehr

⊛ SI2308DS-T1-E3	↔ SI2308DS-T1-GE3	⇒ SI2309BDS-T1-E3	D SI2309BDS-T1-GE3	↔ SI2309CDS-T1-GE3
↳ SI2309CDS-T1-GE3	⊛ SI2309DS	D SI2309DS-T1	⇒ SI2309DS-T1-E3	↔ SI2309DS-T1-E3
⊛ SI2309DS-T1-GE3	↳ SI2309DS-T1-E3	⊛ SI2309DS/A92T	↔ SI2310DS	↔ SI2310DS-T1-E3
D SI2310DS-T1-GE3	⊛ SI2311DS	↳ SI2311DS-T1	⊛ SI2311DS-T1-E3	↔ SI2311DS-T1-E3
⇒ SI2311DS-T1-GE3	↔ SI2311DS-T1-GE3	⊛ SI2312BDS	↳ SI2312BDS-T1-E3	↔ SI2312BDS-T1-E3
↔ SI2312BDS-T1-GE3	⇒ SI2312CDS-T1-E3	D SI2312CDS-T1-GE3	⊛ SI2312CDS-T1-GE3	↳ SI2312DS
⊛ SI2312DS-T1	D SI2312DS-T1-E3	⇒ SI2312DS-T1-GE3	↔ SI2313DS	↔ SI2313DS-T1-E3
↳ SI2313DS-T1-GE3	⊛ SI2314DS	↔ SI2314DS-T1-E3	⇒ SI2314DS-T1-GE3	↔ SI2314EDS
⊛ SI2314EDS-T1-E3	↳ SI2314EDS-T1-E3	⊛ SI2314EDS-T1-GE3	D SI2314EDS-T1-GE3	↔ SI2315BDS
↔ SI2315BDS-T1-E3	⊛ SI2315BDS-T1-E3	↳ SI2315BDS-T1-GE3	⊛ SI2315BDS-T1-GE3	↔ SI2315DS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited